

О КВАНТОВОМ ПРЕДЕЛЕ ДЛЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ СЛАБОИОНИЗОВАННОГО ГАЗА В ПОЛЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А. В. Назаркин, И. В. Сметанин

Задача о нахождении функции распределения электронов слабоионизованного газа в поле электромагнитной волны при учете только упругих соударений электронов с тяжелыми частицами обычно рассматривается в рамках классической теории. При наиболее простых зависимостях транспортного сечения от энергии $\sigma_T(\varepsilon)$ для изотропной части функции распределения классическая теория дает распределение Максвелла ($\sigma_T(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-1/2}$) или Маргенау ($\sigma_T(\varepsilon) = \text{const}$) со средней энергией, зависящей от поля [1, 2]. Указанные результаты справедливы при условии, что средняя энергия электронов $\bar{\varepsilon}$ значительно превышает величину кванта излучения $\hbar\omega$.

В оптическом диапазоне частот, однако, возможна ситуация, когда $\bar{\varepsilon} < \hbar\omega$, и тогда функцию распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) в поле световой волны следует искать из решения квантового кинетического уравнения (ККУ). Целью настоящей работы и является исследование такого сугубо квантового случая.

В присутствии только упругих потерь ККУ для ФРЭЭ $n(\varepsilon, t)$ имеет следующий вид [3]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial n(\varepsilon)}{\partial t} = & \nu_a(\varepsilon - \hbar\omega) n(\varepsilon - \hbar\omega) - (\nu_a(\varepsilon) + \nu_b(\varepsilon)) n(\varepsilon) + \\ & + \nu_b(\varepsilon + \hbar\omega) n(\varepsilon + \hbar\omega) + \frac{2m}{M} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon \nu_T(\varepsilon) n(\varepsilon)), \end{aligned} \quad (1)$$

где $\nu_a, \nu_b(\varepsilon)$ — частоты квантовых «скачков» с поглощением (a) или излучением (b) электроном тормозного фотона $\hbar\omega$, которые зависят от энергии электрона и параметров среды и излучения следующим образом [4]:

$$\nu_a(\varepsilon) = \frac{8\pi e^2}{3mc} \frac{FN}{\omega^2 + \nu_T^2} \left[\frac{2(\varepsilon + \hbar\omega)}{m} \right]^{1/2} \frac{\varepsilon + \hbar\omega/2}{\hbar\omega} \sigma_T(\varepsilon + \hbar\omega/2), \quad (2a)$$

$$\nu_b(\varepsilon) = \left[\frac{\varepsilon - \hbar\omega}{\varepsilon} \right]^{1/2} \nu_a(\varepsilon - \hbar\omega). \quad (2b)$$

В (2) e, m — заряд и масса электрона, $F = (cE^2)/(8\pi\hbar\omega)$ — плотность потока фотонов в поле амплитуды E и частоты ω , N — концентрация рассеивающих частиц массы M , $\nu_T(\varepsilon) = (2\varepsilon/m)^{1/2} N \sigma_T(\varepsilon)$ — частота упругого рассеяния электрона.

Интересующий нас случай соответствует ситуации, когда за время тормозного поглощения ν_a^{-1} кванта излучения электрон теряет на упругих соударениях энергию, превышающую величину кванта, т. е.

$$\Delta\varepsilon_{\text{упр}} \simeq \frac{2m}{M} \frac{\nu_T}{\nu_a} \varepsilon > \hbar\omega.$$

С учетом (2a) указанное условие можно переписать в виде ограничения на величину напряженности светового поля

$$E^2 < E_{\text{кр}}^2 = 6 \frac{m^2(\omega^2 + \nu_T^2)}{Me^2} \hbar\omega. \quad (3)$$

Можно ожидать, что при условии (3) ФРЭЭ заметно меняется в масштабе $\hbar\omega$ и сосредоточена в основном в области малых энергий $\varepsilon \leq \hbar\omega$. Поэтому, переходя от $n(\varepsilon)$ к функции $f(\varepsilon) = n(\varepsilon)\varepsilon^{-1/2}$, рассмотрим для нее ККУ в области $0 \leq \varepsilon \leq \hbar\omega$. Интересуясь стационарной $f(\varepsilon)$, из (1) получим уравнение

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^2 \nu_T(\varepsilon) f(\varepsilon)) = \lambda(\varepsilon) \sqrt{\varepsilon} (f(\varepsilon) - f(\varepsilon + \hbar\omega)), \quad (4)$$

где $\lambda(\varepsilon) = (M\nu_a(\varepsilon))/(2\sqrt{2m}N)$.

Формальное решение (4) имеет вид

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2 \nu_T(\varepsilon)} \exp(-\Phi(\varepsilon)) \left\{ (\hbar\omega)^2 \sigma_T(\hbar\omega) f(\hbar\omega) + \right.$$

$$+ \int_{\varepsilon}^{\hbar\omega} \lambda(x) \sqrt{x} f(x + \hbar\omega) \exp(\Phi(x)) dx \Big\}, \quad (5)$$

где

$$\Phi(\varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{\hbar\omega} \frac{\lambda(x) dx}{\sigma_x(x) x^{3/2}}.$$

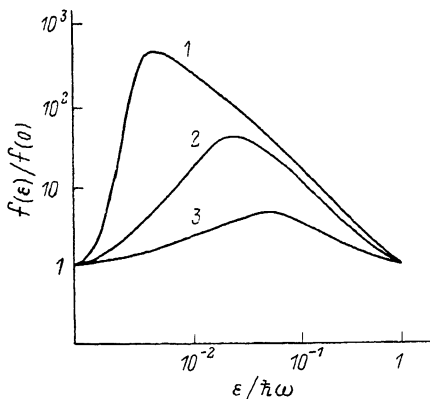
Согласно (5), явный вид $f(\varepsilon)$ в области энергий $0 \leq \varepsilon \leq \hbar\omega$ можно найти, лишь зная решение на следующем интервале $f(\varepsilon + \hbar\omega)$, для чего требуется знание $f(\varepsilon + 2\hbar\omega)$, и т. д. Анализ, однако, существенно упрощается в пределе сильных упругих потерь. Ниже будет рассматриваться именно этот случай.

Полагая $\sigma_x(\varepsilon)$ слабо меняющейся в области $\varepsilon \leq \hbar\omega$ функцией¹ (в силу (2а) это означает также и медленность $\lambda(\varepsilon)$), из (5) получаем, что вблизи $\varepsilon=0$ $f(\varepsilon)$ существенно меняется в масштабе энергий порядка $(2\lambda/\sigma_x)^2 \sim (E/E_{cr})^4 \hbar\omega$. Предел сильных упругих потерь соответствует условию

$$\left(\frac{2\lambda}{\sigma_x}\right)^2 \ll \hbar\omega \quad (6)$$

или же, другими словами, требованию малости поля по сравнению с критическим $E \ll E_{cr}$.

Если (6) выполнено, то можно показать, что основной вклад в решение на интервале



Функция распределения электронов по энергии в поле лазерного излучения с квантом $\hbar\omega$ при различных значениях средней энергии электронов $\bar{\varepsilon}$.

1 — $\bar{\varepsilon}/\hbar\omega = 1.6 \cdot 10^{-1}$, 2 — $3.4 \cdot 10^{-1}$, 3 — $5 \cdot 10^{-1}$.

$0 \leq \varepsilon \leq \hbar\omega$ дает первый член в (5). Исключение составляет малая область энергий $\varepsilon \ll (\lambda/2\sigma_x)^2$, где доминирует второй член. Решение в этой области может быть легко получено как из (5), так и непосредственно из ККУ (4) в виде ряда по малому параметру $\xi = (2\sigma_x/\lambda)\sqrt{\varepsilon}$

$$f(\varepsilon) = f(\hbar\omega) \left[1 + \xi + \frac{5}{16} \xi^2 + \dots \right]. \quad (7)$$

Таким образом, $f(0) = f(\hbar\omega)$, уже здесь видно отличие квантовой ФРЭЭ от классической: согласно (7), с ростом энергии $f(\varepsilon)$ возрастает, тогда как распределения Максвелла и Марганау для $f(\varepsilon)$ дают решения, монотонно убывающие на всей энергетической оси. Это означает, что в квантовом случае $f(\varepsilon)$ обязательно имеет «горб».

Вне рассмотренной выше малой области энергий, т. е. при $\varepsilon \geq (\lambda/2\sigma_x)^2$, решение имеет вид

$$f(\varepsilon) \approx \frac{(\hbar\omega)^2}{\varepsilon^2} f(\hbar\omega) \exp\left\{-\frac{2\lambda}{\sigma_x}(\varepsilon)^{-1/2}\right\}. \quad (8)$$

Максимум функции достигается в точке $\varepsilon_1 = (1/4)(\lambda^2/\sigma_x^2)$, где $f(\varepsilon_1) \sim (\hbar\omega)^2(\sigma_x/2\lambda)^4 f(\hbar\omega) \gg f(\hbar\omega)$ и значительно превышает значение функции на границах интервала (см. рисунок). Наличие максимума у $f(\varepsilon)$ имеет чисто квантовое происхождение и объясняется тем, что потери энергии электронами на упругих соударениях убывают при $\varepsilon \rightarrow 0$, так как пропорциональны энергии электрона, в то время как набор энергии в поле осуществляется конечными порциями энергии $\hbar\omega$. В стационарной ситуации дисбаланс потоков в энергетическом пространстве может быть устранен лишь большим положительным градиентом $f(\varepsilon)$ в области малых энергий, что и приводит к образованию пика. Установление стационарной ФРЭЭ при этом происходит за время порядка времени квантового скачка $\nu_n^{-1}(0)$.

Найдем теперь асимптотику $n(\varepsilon)$ при больших энергиях $\varepsilon \gg \hbar\omega$. Из (1) в предположении $n(\varepsilon - \hbar\omega)/n(\varepsilon) = \alpha(\varepsilon) \gg 1$, где $\alpha(\varepsilon)$ — функция, медленно меняющаяся в масштабе кванта, получаем

¹ Последнее справедливо для газов, не обладающих сильно выраженным рамзауэровским минимумом сечения.

$$n(\varepsilon) = \frac{\text{const}}{\varepsilon v_T(\varepsilon)} a^{-\varepsilon/h\omega}, \quad (9)$$

причем α удовлетворяет уравнению

$$\frac{\ln \alpha}{\alpha} = \left(\frac{E}{E_{кр}} \right)^2. \quad (10)$$

Таким образом, формулы (7)—(10) полностью определяют вид ФРЭЭ во всем диапазоне энергий.

Средняя энергия электронов для найденной ФРЭЭ имеет вид

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^{\infty} \varepsilon n(\varepsilon) d\varepsilon \left/ \int_0^{\infty} n(\varepsilon) d\varepsilon \approx \frac{1}{6} \frac{M e^2 E^2}{m^2 (\omega^2 + \nu_T^2)}. \quad (11)$$

Любопытно, что в нашем квантовом случае средняя энергия (11) оказалась равной (с точностью до множителя порядка 1) средней для классического максвелловского распределения в поле такой же напряженности и частоты.

В заключение оценим интенсивности полей, при которых квантовые эффекты существенны. Имея в виду плазму тяжелых инертных газов ($m/M \sim 10^{-5}$) для излучения с $\hbar\omega = 3$ эВ, из (3) получим оценку $S < 3 \cdot 10^9$ вт/см², т. е. в видимом диапазоне поля могут быть близкими к пробойным [5]. В работе [6] показано, что в поле излучения с квантом, превышающим энергетическую ширину зоны, занимаемой возбужденными уровнями атома, порог пробоя газа резко снижается, так как электрон практически не теряет энергию на возбуждение. В этой ситуации учет рассмотренных нами эффектов может стать принципиальным, поскольку именно упругие потери будут определять минимальную величину порога.

Список литературы

- [1] Margenau H. // Phys. Rev. 1946. Vol. 69. P. 508—513.
- [2] Druyvesteyn M. Y. // Physica. 1930. Vol. 10. P. 64—68.
- [3] Зельдович Я. Б., Райзер Ю. П. // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. Вып. 12. С. 1150—1162.
- [4] Phelps A. V. Physics of Quantum Electronics. New York, 1966. 538 p.
- [5] Buscher H. T., Tomlinson R. G., Damon E. K. // Phys. Rev. Lett. 1965. Vol. 15. P. 847—850.
- [6] Клишков В. К., Назаркин А. В., Норинский Л. В., Рогов В. С. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. Вып. 19. С. 1186—1190.

Московский радиотехнический институт АН СССР

Поступило в Редакцию
15 июня 1989 г.

ПРОВОДИМОСТЬ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ГЕТЕРОГЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОЛИМЕР—НЕЛИНЕЙНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК

Е. В. Харитонов, О. И. Ольшевский, Е. Л. Сейсан,
А. Ф. Тихомиров, Т. И. Ярошецкая

В гетерогенных системах диэлектрик—линейный полупроводник (проводник) при увеличении концентрации проводящей фазы наблюдаются пороговый перколяционный рост проводимости и низкочастотный рост эффективной диэлектрической проницаемости. Максимум диэлектрической проницаемости является следствием резкой неоднородности системы по проводимости и определяется параметром $\omega\tau = \omega\varepsilon_d/\sigma_M$ (ω — круговая частота, ε_d — диэлектрическая проницаемость диэлектрической фазы, σ_M — проводимость проводящей фазы, $\tau_d \ll \sigma_M$, $\omega\tau \ll 1$) (см., например, [1, 2]). Поэтому в случае резкой полевой зависимости проводимости нелинейного полупроводника $\sigma_M = \sigma_M(E)$ для композита $\tau = \tau(E)$ появляются полевые зависимости $\sigma(E)$ и $\varepsilon(E)$ композита, а при $d\sigma_M/dE > 0$ параметр $\omega\tau$ (эффективная